

ПРОГРАММА 54-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУЛИНОВСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ФИЗИКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ С КРИСТАЛЛАМИ.

1-й день, вторник 27 мая

9⁰⁰-10⁰⁰ Регистрация

10⁰⁰-10²⁰ Вступительное слово. Регламент конференции

Секция I

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УСКОРЕННЫХ ЧАСТИЦ С ВЕЩЕСТВОМ (ПРИГЛАШЕННЫЕ
ДОКЛАДЫ С ОБЗОРОМ НОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В
ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ)**

Председатель Н.Г. Чеченин

10 ²⁰ -10 ⁵⁰ Н.Н. Андрианова, А.М. Борисов, М.А. Овчинников.	2
Имитация реакторного облучения материалов ионным облучением.	
10 ⁵⁰ -11 ²⁰ Попов В.П., Подлесный С.Н., Карташов И.А., Антонов В.А., Живодков Ю.А., Пальянов Ю.Н. Генерация NV-центров в nanoструктурах алмаза: ФЛ, ОДМР и когерентность спинов	3

II

1-й день, вторник 27 мая

Секция II

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИОНОВ С ПОВЕРХНОСТЬЮ И НАНОСТРУКТУРАМИ (РАССЕЯНИЕ, РАСПЫЛЕНИЕ, НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ И ЭМИССИЯ ВТОРИЧНЫХ ЧАСТИЦ)

1-е заседание, 11²⁰-12⁵⁰

Председатели В.С. Черныш, В.С. Ковивчак

11 ²⁰ -11 ³⁵ А.Н. Зиновьев, П.Ю. Бабенко, В.С. Михайлов, А.В. Смаев. Теория распыления материалов легкими атомами.	7
11 ³⁵ -11 ⁵⁰ А.И. Мусин, В.Н. Самойлов, П.В. Аристархов, Е.Е. Карпова Модель Кувакина сферического потенциального барьера с преломлением в задаче распыления (001) Au.	8
11 ⁵⁰ -12 ⁰⁵ А.И. Кудюкин, Е.Н. Моос, В.А. Степанов, К.И. Бобровский Ионизация поверхности под действием плазменного разряда.	9
12 ⁰⁵ -12 ²⁰ А.А. Соловых, Е.Н. Воронина Механизмы модификации и разрушения фторуглеродных пленок ионами Ar^+ и O_2^+ .	10
12 ²⁰ -12 ³⁵ Ю.А. Мелкозерова, С.С. Москаленко, И.К. Гайнуллин Резонансный электронный обмен при рассеянии щелочных ионов на металлических поверхностях: Теоретическое моделирование на основе гамильтониана Андерсона-Ньютона.	11
12 ³⁵ -12 ⁵⁰ Н.Н. Михеев Новая методика расчета тормозной способности вещества для пучка ионов средних и низких энергий.	12

12⁵⁵-13¹⁵ *Общее фотографирование*

13¹⁵-14¹⁵ *Перерыв на обед*

III

2-е заседание, 14¹⁵-16¹⁵

Председатели А.М. Борисов, А.А. Шемухин

14 ¹⁵ -14 ³⁰ <u>В.Е. Пуха, Е.Н. Кабачков, Г.В. Нечаев, И.Н. Лукина, Е.И. Дроздова, О.П. Черногорова, Н.А. Романова</u> Структура и свойства покрытий, осажденных из ускоренных ионов трифторметилфуллерена.	13
14 ³⁰ -14 ⁴⁵ <u>Д.А. Стрижкин, К.П. Карасев, П.А. Карасев, А.И. Титов, А.Л. Шахмин, Е.Д. Федоренко</u> Формирование переходного слоя при облучении кремния ионами С ₆₀ .	14
14 ⁴⁵ -15 ⁰⁰ <u>И.В. Nikolaev, Н.Г. Коробейщиков</u> . МД моделирование взаимодействия кластерных ионов аргона с монокристаллическим кремнием и германием.	15
15 ⁰⁰ -15 ¹⁵ <u>Н.Г. Коробейщиков, И.В. Nikolaev, М.В. Яковлева</u> Наноструктурирование поверхности германия кластерами аргона.	16
15 ¹⁵ -15 ³⁰ <u>М.А. Землякова, Р.А. Рымжанов, В.А. Скуратов</u> Моделирование эффектов облучения нитрида алюминия быстрыми тяжелыми ионами.	17
15 ³⁰ -15 ⁴⁵ <u>Р.А. Воронков, Д.И. Зайнутдинов, Н.А. Медведев, А.Е. Волков</u> Моделирование коллапса запрещенной зоны диэлектриков в треках быстрых тяжелых ионов	18
15 ⁴⁵ -16 ⁰⁰ <u>Д.И. Зайнутдинов, А.Е. Волков</u> Влияние температуры облучения быстрыми тяжелыми ионами на формирование треков в тонких SiC пленках	19
16 ⁰⁰ -16 ¹⁵ <u>В.П. Попов, В.А. Антонов, В.А. Жилицкий, А.К. Гутаковский, А.А. Ломов, А.В. Мяконьких, К.В. Руденко, Ж. О'Коннелл, В.А. Скуратов</u> . КНИ транзисторы с межслойным диоксидом гафния, облученные быстрыми ионами Xe и Bi.	20

16¹⁵-16³⁰ Перерыв

16³⁰-18⁰⁰ Обсуждение стендовых докладов

Стендовые доклады секции «Взаимодействие ионов с поверхностью и наноструктурами (рассеяние, распыление, наноструктурирование и эмиссия вторичных частиц)»

Председатель А.П. Евсеев

1. <u>Ф.Ф. Арзиколов, Ш.К. Кучканов, И.О. Косимов, К.Ё.Камбаралиев</u> . Физические и химические свойства бинарных полупроводников оксида меди.	21
2. <u>U. Uljayev, A. Ulukmuradov, K. Mehmomonov, U. Khalilov</u> . Effect of temperature change on hydrogen adsorption of α-SiO ₂ .	22

IV

- | | | |
|-----|---|----|
| 3. | А.А. Абдувайитов, Д.А.Ташмухамедова, Х.Х.Болтаев, И.К.Кодирова, Ш.А.Талипова. Состав и электронная структура поверхности тонких пленок полупроводник-металл | 23 |
| 4. | А.А.Абдувайитов, Б.Е.Умирзаков, Х.Х.Болтаев, Х.М.Шамаев, Г.Н.Турапова. Электронная спектроскопия наноструктур, созданных в поверхностных слоях Si и CaF ₂ методом низкоэнергетической ионной имплантации | 24 |
| 5. | Д.В. Алябьев, И.Д. Ядгаров. Исследование процессов осаждения экзоэрдальных фуллеренов C ₆₀ ⁺ Fe на поверхность кристалла железа методами молекулярной динамики | 25 |
| 6. | В.А. Андианов, А.Л. Ерзинян, А.А. Буш, П.А. Федин, К.Е. Прянишников, Т.В. Кулевой, А.Л. Тригуб. Локализация ионов Fe при имплантации в кристалл ZrO ₂ , данные XANES. | 26 |
| 7. | И.Х. Худайкулов, В.Н.Арутсатов, Б.Р. Каҳрамонов. Влияние магнитного поля тока в катоде, на формирование катодных пятен. | 27 |
| 8. | В.Н.Арутсатов, И.Х. Худайкулов, Б.Р. Каҳрамонов. Оценка покрытия, сформированного методом магнетронного распыления и вакуумного дугового разряда. | 28 |
| 9. | И.Х. Худайкулов, В.Н.Арутсатов, Б.Р. Каҳрамонов. Фазовый анализ поверхности металла, очищенного методом вакуумного дугового разряда. | 29 |
| 10. | Ш.М. Ахмедов, Ш.Дж. Ахунов, А.Ш. Раджабов, М.М. Назаров, О.И. Болийев, Д.Т. Усманов. Исследование закономерности поверхностной ионизации молекул диазиона. | 30 |
| 11. | Ш.М. Ахмедов, Ш.Дж. Ахунов, А.Ш. Раджабов, Д.Т. Усманов Определение имидоклоприда в томатном соке методом поверхностной ионизации. | 31 |
| 12. | Ш.М. Ахмедов, Ш.Дж. Ахунов, М.М. Назаров, О.И. Болийев, А.Ш. Раджабов, Д.Т. Усманов. Определение энергии активации иона, образованного при мономолекулярном распаде молекул хлордимеформа. | 32 |
| 13. | Ш.Дж. Ахунов, Р. Джаббарганов. Исследование ионизации кластерных ионов при напылении атомов калия на распыляемой поверхности алюминия ионами Cs ⁺ . | 33 |
| 14. | П.А. Бабаев, А.Е. Волков. Повреждение оргстекла быстрыми тяжелыми ионами: тонкая плёнка и объёмная мишень. | 34 |
| 15. | У.Ф. Бердиев. Нанокомпозитные протонообменные мембранны. | 35 |
| 16. | Д.Р. Бессмертный, И. Н. Кутлусурин, Д.С. Киреев, А.Е. Иешкин, А.А.Татаринцев. Формирование волнообразного рельефа на поверхности 3D сплавов Ti ₆ AlV и Al ₁₀ SiMg под действием ионного кластерного облучения. | 36 |
| 17. | Р. Джаббарганов, Б.Г. Атабаев, А.С. Халматов. Исследование отрицательно ионного распыление карбида ниobia NbC ионами Cs ⁺ . | 37 |
| 18. | Р. Джаббарганов, Б.Г. Атабаев, А.С. Халматов. Массспектрометрический элементный анализ окись магния (MgO) при распыления ионами Cs ⁺ . | 38 |

19.	М. Нормурадов, К. Довранов, Х. Туракулов, М. Давлатов, А. Кодиров, Х. Давранов, Д. Нормуминова. Формирование медных нанопленок в различных режимах постоянного и радиочастотного тока.	39
20.	Х.И. Жабборов, Б.Е. Умирзаков, И.Д. Ядгаров. Определение длина связи атомов металлов (Ni, Ti, Fe) с молекулой фуллерена C ₆₀	40
21.	А.А. Зарипов, И.Х. Худайкулов. Синтез и спектроскопия мультикомпонентных наночастиц методом искрового разряда.	41
22.	З.А. Исаханов, Б.Е. Умирзаков, И.О. Косимов, М.М. Махмудов, А.С. Халматов. Влияние умма-излучения на кристаллическую структуру тонкого покрытия TiO ₂ , полученного на поверхности Si (111).	42
23.	С.С. Исхакова, Т.Х. Эрова, Ш.М. Ахмедов, З.А. Улашева. Исследования наркотических и психоактивных веществ методом поверхностной ионизации.	43
24.	С.С. Исхакова, Т.Х. Эрова, Ш.Т. Тоиров, Ш.М. Ахмедов. Термоионная эмиссия молекул злоупотребляемых новых психоактивных веществ.	44
25.	П.Г. Каҳрамонова, Ш.Дж. Ахунов, Д.Т. Усманов. Ионно-фотонная эмиссия при бомбардировке Tm мишени кластерными ионами висмута.	45
26.	Е.К. Самбаев, А.Л. Козловский, В.В. Углов. Влияние вариации фазового состава ZrO ₂ керамик стабилизованных Y ₂ O ₃ на устойчивость к радиационным повреждениям.	46
27.	С.Б. Азамбаев, А.Л. Козловский. Определение влияния вариации условий облучения на устойчивость к радиационным повреждениям приповерхностного слоя Al ₂ O ₃ -Si ₃ N ₄ керамик.	47
28.	Х.Г. Комилова, Д.Т. Усманов. Масс-спектрометрические исследования закономерностей поверхностной ионизации амфетамина и метамфетамина.	48
29.	Г.Г. Бондаренко, Д.О. Савичкин, М.Р. Фишер, В.И. Кристя. Моделирование влияния температуры на взаимодействие катода с тонкой диэлектрической пленкой и плазмы тлеющего газового разряда в смеси аргона и паров ртути.	49
30.	А.И. Кудюкин. Анализ хаотического рельефа и шероховатости поверхности после воздействия плазменной дуги.	50
31.	А.И. Кудюкин. Воздействие плазменного разряда на контакты электродов.	51
32.	Р.Т.Курбанов, С.Е.Максимов, Ш.Т.Хожиев. Металл-углеродные кластеры, распыленные ионами Cs ⁺ с границы раздела железо-углерод.	52
33.	В.С. Михайлов, П.Ю. Бабенко, А.Н. Зиновьев. Распыление вольфрама альфа-частицами МэВ-ных энергий.	53
34.	С.С. Москаленко, Ю.А. Мелкозерова, И.К. Гайнуллин. Моделирование скользящего рассеяния ионов на на металлических поверхностях.	54

VI

35. А.И. Мусин, В.Н. Самойлов, Н.Г. Ананьева. Влияние ближайшего атомного окружения на эффект блокировки атомов при эмиссии с поверхности (001) Au 55
36. А.К. Ташатов, Н.М. Мустафоева, С.Ш. Кучаров, Х.Ш. Норкулова. Механизмы создания согласующихся слоев на границах раздела систем CaF₂/GaAs и GaAs/CaF₂. 56
37. Б.Л. Оксенгендлер, И.Нуритдинов, С.Х.Сулейманов, С.Е.Максимов, А.Ф.Зацепин, Н.Н. Никифорова, Ф.О.Олимжонова. Аспекты современных концепций взаимодействия заряженных частиц со сложными средами. 57
38. Е.В. Окулич, Д.В. Гусейнов, М.Н. Коряжкина, Д.И. Тетельбаум, Н.О. Бартев, Н.Г. Данченко, В.А. Пикарь, А.В. Тетеревков, А.Н. Михайлов. Имитационное моделирование воздействия радиации на мемристоры на основе ZrO₂(Y). 58
39. Е.В. Окулич, Д.И. Тетельбаум, В.И. Окулич. Компьютерное моделирование модификации структуры β -Ga₂O₃ при ионном облучении. 59
40. М.Х. Отахонова, Д.Т. Усманов. Развитие поверхностной ионизации для прямого обнаружения кокаина в биологических матрицах 60
41. А.Ф. Вяткин, А.Н. Пустовит. Модификация коэффициентов распыления с учетом рассеяния ионов поверхностными атомами мишени. 61
42. А.Ш. Раджабов, Д.Т. Усманов, С.С. Исхакова. Исследование закономерностей зависимости гетерогенных химических реакций молекул органических соединений от напряженности электрического поля при их поверхностной ионизации на поверхности окисленного вольфрама. 62
43. А.Ш. Раджабов, Д.Т. Усманов. Исследования закономерностей образования протонированных ионов при поверхностной ионизации молекул органических соединений в сильных электрических полях. 63
44. А.Ш. Раджабов, Д.Т. Усманов. Исследования закономерностей поверхностной ионизации молекул триэтиламина под действием сильного электрического поля 64
45. Е.В. Серегина, М.А. Степович, М.Н. Филиппов, В.В. Калманович. О трёхмерной модели диффузии неравновесных неосновных носителей заряда, генерированных электронным зондом в однородной полупроводниковой мишени. 65
46. В.М.Студзинский, А.И.Клевцов, Е.Д.Федоренко, А.С. Кондратьева, П.А.Карасев. Применение анализа фрактальной размерности кnanoструктуркам золота получаемым ионной бомбардировкой. 66
47. L. Forlano and A. I. Tolmachev. Calculation of ion reflection from solid in the small angle approximation. 67
48. З.А. Шарипов, Б. Батгэрэл, И. Сархадов, З.К. Тухлиев, И.Г. Христов, Р.Д. Христова. Молекулярно-динамическое 68

VII

	моделирование термоупругих процессов в металлах при облучении ускоренными частицами	
49.	Е.Д. Федоренко, А.И. Клевцов, А.А. Воробьев, П.А. Карапасев, А.И. Титов. Исследования электрических и радиационных свойств контактов металл – альфа оксид галлия	69
50.	Ф.А. Хайдаров, З.И. Искандарова, У.Б. Халилов. Адсорбция метановой плазмы на никеле.	70
51.	Н.Н. Андрианова, А.М. Борисов, Р.Р. Мулюков, М.А. Овчинников, Р.Х. Хисамов. Коэффициенты распыления металлов С различным размером зерен при высоких флюенсах облучения ионами аргона и гелия с энергией 30 кэВ.	71
52.	Ш.Т.Хожиев, Б.Б.Гаиназаров, В.М.Ротштейн. Кластеры $\text{Si}_n\text{O}_m\text{H}_k$, распыленные при ионной бомбардировке поверхности кремния.	72
53.	Д.Х. Хусanova, С.З. Мирзаев и У.Б. Халилов. Моделирование пренуклеации перилена на Ni (331).	73
54.	В.Н. Черник, Л.С. Новиков, Л.А. Жиляков. Изменение электропроводности покрытия ито при облучении потоком кислородной плазмы.	74
55.	M.B. Choriyeva, I.Z. Urolov, I.D. Yadgarov. Computer modeling of the interaction process of the fullerene C_{60} molecule with the surface of an aluminum substrate.	75
56.	В.П. Кощеев, Ю.Н. Штанов. Влияние атомного форм – фактора на эффект канализирования в кристалле кремния.	76
57.	В.И. Шульга. Эффекты кристаллической структуры мишени и поверхностного рельефа в распылении.	77
58.	Aziza Ergasheva and Umedjon Khalilov. A nucleation mechanism of zinc-based MOF structures.	78
59.	И.Д. Ядгаров, И.З. Уралов. Моделирование процессов адсорбции кластеров $\text{C}_n@\text{C}_{20}$ и $\text{C}_n@\text{C}_{60}$ на поверхности кремния Si (001)	79
60.	Sh.M. Akhmedov, S.S. Iskhakova, Sh.Dj. Akhunov, T.Kh. Erova, Sh.T. Toirov, D.T. Usmanov. Surface ionization regularities of the sibutramine molecule.	80
61.	O.I. Boliyev, M.M. Nazarov, Sh.M. Akhmedov, Sh.Dj. Akhunov, A.Sh. Radjabov, D.T. Usmanov. Surface ionization of melamine molecules on the rhenium and tungsten emitters.	81
62.	D. Boymamatova, D. Kuchkarova, A. Ergasheva and U. Khalilov. Nickel-filled carbon nanotubes for wastewater purification.	82
63.	Tursunpulat Juraboev, Madina Nurimmatova, Umedjon Khalilov Gaphene nucleation onset by polycyclic aromatic hydrocarbons.	83
64.	Kamoliddin Mehmomonov, Aziza Ergasheva, Salokhiddin Khudoyberdiyev, and Umedjon Khalilov. Catalytic synthesis kinetics of endohedral GNRS.	84
65.	M.M. Nazarov, A.Sh. Radjabov, Sh.M. Akhmedov, Sh. Dj. Akhunov, D.T. Usmanov. Determination of kinetic characteristics of melamine molecules using the voltage modulation method.	85

VIII

- | | | |
|-----|---|----|
| 66. | М. Нормурадов, К. Довранов, А. Кодиров, Д. Нормуминова. | 86 |
| | SEM-изображение монокристаллического кремния Si(111). | |
| 67. | А.Ф. Тураев, У.Б. Шаропов, М.С.Пайзуллаханов. | 87 |
| | Кристаллическая структура кобальтита феррита различным стехиометрическим составом. | |
| 68. | А.Ф. Тураев, У.Б. Шаропов, М.С.Пайзуллаханов. | 88 |
| | Электронная структура кобальтита феррита различным стехиометрическим составом | |
| 69. | А.В. Бибиков, А.В. Николаев, П.В. Борисюк, Е.В. Ткаля. | 89 |
| | Изучение проникновения атомов и ионов бора и бериллия внутрь фуллерена C ₆₀ AB-INITIO методами (DFT) | |

18³⁰-21⁰⁰ Конференционный ужин

2-й день, среда 29 мая

Секция III

ОРИЕНТАЦИОННЫЕ И РЕЛЯТИВИСТСКИЕ ЭФФЕКТЫ, ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ, ИЗМЕНЕНИЕ ЗАРЯДОВОГО СОСТОЯНИЯ ЧАСТИЦ

10⁰⁰-11¹⁵, 1-е заседание

Председатели Кузнецов А.А., В.С. Малышевский

- | | | |
|------------------------------------|--|----|
| 10 ⁰⁰ -10 ¹⁵ | В.П. Афанасьев, Л.Г. Лобанова Релаксация плазмонов в металлах | 92 |
| 10 ¹⁵ -10 ³⁰ | О.В. Богданов, С.В. Брагин Особенности генерации закрученных фотонов в эллиптических ондуляторах | 93 |
| 10 ³⁰ -10 ⁴⁵ | Н.П. Калашников, А.С. Ольчак Рассеяние лазерных фотонов на встречном пучке | 94 |
| 10 ⁴⁵ -11 ⁰⁰ | Н.П. Калашников, А.С. Ольчак Квази-канализование: не финитное периодическое движение частиц вдоль атомных плоскостей в кристалле | 95 |
| 11 ⁰⁰ -11 ¹⁵ | Е.А. Мазур Излучение жестких гамма-квантов заряженной ориентированной частицей в кристалле | 96 |
| 11 ¹⁵ -11 ³⁰ | Н.А. Ашурко Возбуждение гигантского дипольного резонанса в ядрах излучением канализированных релятивистских электронов в кристалле Si | 97 |
| 11 ³⁰ -11 ⁴⁵ | Н.В. Новиков, Н.Г. Чеченин, А.А. Широкова Расчет коэффициента электронной эмиссии при прохождении быстрых ионов через кремний | 98 |

11⁴⁵-12⁰⁰ Перерыв

Секция IV**МОДИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ
ИОННЫМИ И ЭЛЕКТРОННЫМИ ПУЧКАМИ****12⁰⁰-13¹⁵, 1-е заседание****Председатели: В.С. Ковивчак, В.П. Попов**

12 ⁰⁰ -12 ¹⁵ В.С. Ковивчак Особенности воздействия мощного ионного пучка наносекундной длительности на тонкую пьезоэлектрическую пленку AlN	100
12 ¹⁵ -12 ³⁰ Т.В. Панова, В.С. Ковивчак, К.А. Жувакина Особенности жидкостной коррозии поликристаллического магния, облученного мощным ионным пучком	101
12 ³⁰ -12 ⁴⁵ В.К. Егоров, Е.В. Егоров, В.Т. Волков Влияние толщины Cr покрытия оболочки твэла на степень ее коррозионной стойкости.	102
12 ⁴⁵ -13 ⁰⁰ И.К. Аверкиев, Т.З. Гусейнов, О.Р. Бакиева Исследование локальной атомной структуры тонких пленок TiO _x ; 13 ⁰⁰ -13 ¹⁵ Т.З. Гусейнов, О.Р. Бакиева, Р.Г. Валеев Исследование мемристивных слоев нестехиометрического состава TiO _x .	103
	104

13¹⁵-14¹⁵ Перерыв на обед**14¹⁵-15³⁰, 2-е заседание****Председатели П.А. Карасев, И.И. Ташлыкова-Бушкевич**

14 ¹⁵ -14 ³⁰ А.И. Клевцов, П.А. Карасев, А.И. Титов. Особенности дефектообразования в альфа-оксиде галлия при имплантации ионов разных масс.	105
14 ³⁰ -14 ⁴⁵ Д.С. Королев, А.А. Никольская, К.С. Матюнина, А.А. Конаков, Д.А. Татарский, П.А. Юнин, Д.И. Тетельбаум. Структурные превращения в β-Ga ₂ O ₃ при облучении ионами бора.	106
14 ⁴⁵ -15 ⁰⁰ L.G. Lobanova, S. Wang, Z. Wang, H. Lian, X. Cui, J. Chen, L. Zhang, Y.P. Afanas'ev, M.A. Semenov-Shefov, H. Liu. Модификация поверхности графита после его использования в качестве первой стенки токамака EAST.	107
15 ⁰⁰ -15 ¹⁵ Н.Н. Андрианова, А.М. Борисов, Е.А. Воробьев, М.А. Овчинников. Образование терморасширенного графита при высокодозной имплантации ионов гелия.	108
15 ¹⁵ -15 ³⁰ Д.А. Соколова, О.А. Подсвиров, С.А. Шестаков, А.И. Лихачев Формирование металлических молекулярных кластеров в силикатных стеклах с помощью электронного облучения	109

15³⁰-15⁴⁵ Перерыв

15⁴⁵-17⁰⁰, 3-е заседание**Председатели П.А. Карасев, В.В. Углов**

15 ⁴⁵ -16 ⁰⁰ М.М. Михайлов, С.А. Юрьев, Д.С. Федосов, В.А. Горончко, А.Н. Лапин	Стабильность оптических свойств порошка оксида иттрия при облучении электронами.	110
16 ⁰⁰ -16 ¹⁵ Н.Г. Морев, И.В. Верхогурова, В.В. Нещименко, Ли Чундун	Радиационная стойкость двухслойных полых частиц TiO ₂ /SiO ₂ при облучении протонами.	111
16 ¹⁵ -16 ³⁰ О.М. Марченко, С.А. Бедняков, С.С. Авторин, О.Б. Дзагуров, Н.Б. Акимов, О.П. Глотов, Н.Г. Чеченин	Физические параметры заряженных микрочастиц, полученных при помощи электростатического инжектора	112
16 ³⁰ -16 ⁴⁵ Е.С. Керновский, И.В. Польшин, С.А. Ивков, А.И. Чукавин, Н.С. Буйлов, А.С. Дорошкевич, П.Л. Тuan, А.К. Пелагина, А.В. Ситников, К.А. Барков.	Комплексный элементный анализ тонких пленок Cu _x Si _{1-x} с использованием методов EDS, RBS и XPS.	113
16 ⁴⁵ -17 ⁰⁰ И.И. Ташлыкова-Бушкевич, И.А. Столляр, В.Д. Мурин, А.Ю. Герус	Композиционный состав и характер смачивания нанометровых пленок сплавов алюминия, полученных ионно-ассистированным осаждением.	114

17⁰⁰-17¹⁵ Перерыв**17¹⁵-19⁰⁰ Обсуждение стендовых докладов****Стендовые доклады «Модификация и анализ приповерхностных слоев ионными и электронными пучками» и «Ориентационные и релятивистские эффекты, потери энергии, изменение зарядового состояния частиц»****Стендовые доклады**

1. Н.А. Нурматов, Б.Г. Атабаев, Г.Т. Рахманов, Б. Туракулов, Р.А. Алимов. Н. Талипов. Влияние вакуумного отжига на спектральные характеристики фотоэмиссии кремния Si (100). 115
2. Б.Е. Умирзаков, Ж.М. Жумаев, И.Р. Бекпулатов, Турапов. Получение наноразмерных силицидных пленок MES i₂ для контактной системы. 116
3. Г.М. Ширинов, С.Б. Донаев, Б.Е. Умирзаков. Влияние ионной имплантации и активации на эмиссионные свойства Pd-Ba. 117

- | | | |
|-----|---|-----|
| 4. | Г.М. Ширинов, С.Б. Донаев, Б.Е. Умирзаков. Зависимость ширины запрещенной зоны от размеров нанокристаллических фаз GaAlP | 118 |
| 5. | Д.В. Андреев, В.В. Кузнецов, Г.К. Гришин, В.В. Андреев. Влияние энергии протонов на изменение зарядового состояния структур металл-диэлектрик-полупроводник. | 119 |
| 6. | Д.В. Андреев, С.А. Корнев, В.В. Андреев. Термический и инжекционный отжиг радиационно-индущированного заряда в МОП-структуратах | 120 |
| 7. | Б.Г. Атабаев, Ш.Р. Маликов, З.Ш. Шаймарданов, Ш. Уролов, Р. Жалолов, М.Б. Юлдашев, О.О. Аманов, А.А. Сулаймонов. Образование дефектов ZnO нанокристаллов при гамма-облучении методом фотолюминисценции. | 121 |
| 8. | Р.И. Баталов, В.В. Базаров, И.М. Подлесных, Д.Д. Зайцев. Импульсный отжиг слоёв кремния с примесями индия и мышьяка: моделирование и эксперимент. | 122 |
| 9. | Н.Г. Валько, С.В. Злоцкий, В.В. Углов, В.М. Анищик, Н.А. Павлова, А.М. Кузьмицкий, В.М. Асташинский, Н.И. Мороз. Структурно-фазовое состояние кремнистой стали, модифицированной компрессионными плазменными потоками. | 123 |
| 10. | Г.С. Дегтяренко, В.Е. Пуха, И.И. Ходос. Моделирование процесса формирования защитного нитридного слоя на поверхности титана методом ионной имплантации. | 124 |
| 11. | М.А. Кирсанов, М.А. Негодаев, С.Г. Климанов. Исследование выхода нейтронов в d+d ядерной реакции из кристаллических мишней на ионном ускорителе ГЕЛИС. | 125 |
| 12. | В.В. Козловский, А.Э. Васильев, М.Е. Левинштейн, А.А. Лебедев, Д.А. Малевский, А.М. Стрельчук. Нелинейные дозовые эффекты в компенсации широкозонных галлиевых полупроводников радиационными дефектами. | 126 |
| 13. | В.В. Выходец, Т.Е. Куренных. Критерии для наблюдения туннелирования водорода в металлах. | 127 |
| 14. | Ш.К.Кучканов, Х.Б.Ашуров, Б.М.Абдурахманов, М.М.Адилов, А.И.Камардин, С.Е.Максимов, С.Ж.Ниматов. Генерация ЭДС и токов в эпитаксиальных плёночных структурах Si /Si, обработанных ионами неона. | 128 |
| 15. | В.Ю. Баринов, С.С. Манохин, Ю.Р. Колобов А.Е.Лигачев, Г.В.Потемкин, В.А.Тарбоков, Г.Е.Ремнев. Поверхность псевдосплава w-си после ее обработки импульсным пучком ионов углерода. | 129 |
| 16. | L.G. Lobanova, S. Wang, H. Lian, X. Cui, J. Chen, R. Yan, L. Zhang, V.P. Afanas'ev, M.A. Semenov-Shefov, H. Liu. Плазменно-химический механизм эрозии поверхности зеркал вtokamake EAST. | 130 |
| 17. | К.С. Матюнина, Д.С. Королев, А.А. Никольская, Р.Н. Крюков, А.А. Сушков, Д.А. Павлов, Д.И. Тетельбаум. | |

XII

Влияние времени и температуры отжига на оптические свойства нанокристаллов ga_2o_3 в матрице SiO_2	131
18. О.М. Михалкович, С.М. Барайшук. Анализ глубинного проникновения атомов тантала в кремниевую подложку при формировании пленки катодным вакуумным распылением с ионным асистированием	132
19. С.Ж. Ниматов, Б.Е. Умирзаков, О.О. Зарипов. Исследование режимов получения субмонослойных пленок щелочных металлов.	133
20. Н.И. Поляк, В.М. Анищик, А.Е. Лигачев, В.А. Тарбоков. Структура и фазовый состав стали 65, обработанной импульсным пучком ионов.	134
21. В.В. Поплавский, О.Г. Бобрович, В.Г. Лугин А.А. Могдалова, И.Л. Поболь. Микроструктура и состав слоев, формируемых в процессах ионно-плазменной обработки поверхности сплавов алюминия.	135
22. В.В. Привезенцев, А.А. Фирсов, В.С. Куликаускас, В.В. Затекин, Д.А. Киселев, С.С. Самохина, А.Н. Терещенко. Исследование пленки нитрида кремния, последовательно имплантированной ионами Zn и O.	136
23. А.В. Носков, О.В. Алексеева, Д.Н. Яшкова, А.В. Агафонов, М.Н. Шипко, М.А. Степович, Е.С. Савченко, В.В. Калманович. Исследование свойств и характеристизация композиционных материалов на основе оксидов железа и активированного угля	137
24. А.В. Хлюстова, Н.А. Сироткин, А.В. Агафонов, М.Н. Шипко, М.А. Степович, С.К. Дедушенко, Е.С. Савченко, В.В. Калманович. Исследования особенностей структуры и магнитных свойств нанокомпозитов на основе ферритов-шпинелей, синтезированных плазмохимическим методом в условиях подводной плазмы.	138
25. М.Н. Шипко, Т.П. Каминская, М.А. Степович, А.В. Стулов, Е.С. Савченко, А.В. Хлюстова, Н.А. Сироткин, А.А. Вирюс, В.В. Калманович. О возможности модификации и анализе локальных свойств приповерхностных слоёв ленточных электротехнических материалов.	139
26. Д.В. Туртин, М.А. Степович, В.В. Калманович. О математической модели нестационарного нагрева однородной мишени электронным зондом средних энергий	140
27. А.А. Татаринцев, Е.Ю. Зыкова, А.Е. Иешкин, Н.Г. Орликовская, В.Е. Астахов, А.А. Никольская, Д.И. Тетельбаум. Катодолюминесценция β - Ga_2O_3 , имплантированного ионами кремния.	141
28. Н.В. Ткаченко, А.И. Каменских. Исследование пористых и неоднородных материалов методом ядерного обратного рассеяния.	142

XIII

<p>29. Б.Е.Умирзаков, Д.А.Ташмухамедова, Х.Э.Абдиев, Ж.Б.Хужаниязов, А.Н.Уроков, Б.В. Ибрагимова. Электрофизические свойства системы PdSi/Si. 143</p> <p>30. А.С. Халматов З.А. Исахаев. Влияние примесей на твердофазные реакции в пленках NiW-Si при высоких температурах 144</p> <p>31. Р. Х. Хасаншин, Л. С. Новиков, С.П. Никитин. Эволюция морфологии стекла к-208 при электронно-протонном облучении. 145</p> <p>32. В.Н Арутсамов, И.Х Худойкулов, Б.Р Каҳрамонов, В.Н. Харъяков. Состояния поверхности покрытия, осажденного магнетронным и вакуумно дуговым методом. 146</p> <p>33. М.Б. Юсупжанова, Д.А. Ташмухамедова, В.Х. Холмухамедова, С.Т. Гулямова, С.Т. Абраева, А.У. Хужаниязова. Электронная структура системы MgO/Mg. 147</p> <p>34. Е.К. Городничий, Ф.Г. Нешов, Ю.А. Кузнецова, Д.В. Райков. Влияние химического средства к углероду материала подложки на бактерицидность углеродных плёнок, легированных медью. 148</p> <p>35. О.В. Богданов, Я. Ван, П.О. Казинский. Возбуждение низкоэнергетических переходов в ядрах закрученными фотонами. 149</p> <p>36. А.В. Будко, И.Е. Внуков, В.В. Колодочкин, Y. Takabayashi. Влияние геометрии измерений на угловое распределение дифрагированного переходного излучения релятивистских электронов в кристаллах. 150</p> <p>37. К.А. Вохмянина, И.А. Кищин, А.Д. Пятигор, Е.Ю. Киданова, В.И. Алексеев, А.Н. Елисеев, А.С. Кубанкин. Управление пучком электронов с энергией 7 МэВ с помощью стеклянных каналов. 151</p> <p>38. С.А. Горбунов, М.В. Горшенков, Р.А. Рымжанов, А.Е. Волков, Г.В. Калинина. Сравнение атомно-силовой и сканирующей электронной микроскопии нанопор на поверхности травимых кристаллов оливина, облученных быстрыми тяжёлыми ионами. 152</p> <p>39. В.С. Малышевский, Г.В. Фомин, Н. Хилько. Моделирование рассеяния протонов в тонких монокристаллических пленках. 153</p> <p>40. А.Р. Гучева, В.С. Малышевский, Г.В. Фомин. Черенковское излучение в области вакуумного ультрафиолета. 154</p> <p>41. М.А. Махмудов, З.А. Исаханов, Р.Т. Курбанов, А.А. Ахмедов. Роль полупроводниковых гетероструктур в будущих технологиях электроники. 155</p> <p>42. М.А. Воронков, Е.Н. Моос, И.М. Орешкин. Спектры излучения ионно-распыленных атомов и оптического поглощения образцов фосфида галлия. 156</p>	
---	--

XIV

- | | | |
|-----|--|-----|
| 43. | Н.В. Новиков. База данных распределения электронов в быстрых ион-атомных столкновениях. | 157 |
| 44. | А.В. Носков, С. В. Блажевич, Е.Д. Пронина, С.А. Пирогова. Влияние расходимости пучка релятивистских электронов на ПРИ и ДПИ в периодической среде с тремя слоями на периоде. | 158 |
| 45. | А.В. Носков, С. В. Блажевич, И.Н. Бардакова, Д.Д. Мачукаев, В.К. Киперша , Д.Р. Кадыров. КРИ в периодической слоистой среде с тремя слоями на периоде в направлении скорости излучающего релятивистского электрона. | 159 |
| 46. | А.В. Носков, С. В. Блажевич, И.Н. Бардакова, Л.С. Машковцева, А.И. Ушаков. ПРИ и ДПИ пучка релятивистских электронов в периодической слоистой среде с тремя слоями на периоде в геометрии рассеяния Лауз. | 160 |
| 47. | В.В. Сыщенко, А.И. Тарновский, В.А. Кривцов. Переходное излучение сгустка нерелятивистских частиц на проводящей мишени в виде прямого двугранного угла. | 161 |
| 48. | В.В. Сыщенко, А.И. Тарновский, А.Ю. Исупов. Статистика уровней энергии поперечного движения позитронов с энергиями в интервале 40-50 ГэВ при канализировании в направлении [100] кристалла кремния. | 162 |
| 49. | M. Kh. Khokonov and A. S. Azhakhova. Prospects for studying strong field effects in oriented crystals and powerful laser fields | 163 |
| 50. | M.T. Mamanazarov. Fast-forward cooling dynamics of nanosystems. | 164 |
| 51. | И.Е. Внуков, А.С. Склярова, У. Takabayashi. Оценка спектральной чувствительности рентгенографических пластин с помощью параметрического рентгеновского излучения электронов в кристаллах. | 165 |
| 52. | Н.Н. Михеев, И.Ж. Безбах. Тормозная способность легких углеводородов для ионов средних и низких энергий. | 166 |
| 53. | А.Н. Олейник, М.Э. Гильц, А.С. Кубанкин, П.Г. Шаповалов. Особенности самофокусировки потока электронов в пироэлектрическом ускорителе. | 167 |
| 54. | И.В. Богданов, Л.А. Святкин, Л.Ю. Немирович-Данченко, И.П. Чернов. Механизм переноса возмущений в водородной подсистеме в системе палладий-водород. | 168 |
| 55. | И. Сархадов, З.А. Шарипов, З.К. Тухлиев, Х. Гафуров Численное моделирование стационарных волн лазерной абляции материалов в полуограниченных образцах непрерывным аналогом метода ньютона | 169 |

3-й день, четверг, 29 маяСекция IV**МОДИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ИОННЫМИ И ЭЛЕКТРОННЫМИ ПУЧКАМИ****10⁰⁰-12⁰⁰, 4-е заседание**Председатели В.С. Ковивчак, Ю.В. Балакшин

10 ⁰⁰ -10 ¹⁵ Э.Ф. Хаметова, О.Р. Бакиева, В.В. Кривенцов Разработка метода анализа перекрывающихся EXAFS-сигналов на примере системы Au-Pt	170
10 ¹⁵ -10 ³⁰ Emad M. Elsehly, N.G. Chechenin Thermoelectric performance of Heusler alloys/ ion irradiated multi-walled carbon nanotubes composites.	171
10 ³⁰ -10 ⁴⁵ А.Л. Степанов Дифракционные решетки и фотонные кристаллы на основе имплантированных слоев нанопористого германия.	172
10 ⁴⁵ -11 ⁰⁰ И.В. Польшин, Е.С. Керновский, С.А. Ивков, А.В. Ситников, К.А. Барков Особенности получения тонких пленок Cu-Si методом ионно-лучевого распыления составной мишени.	173
11 ⁰⁰ -11 ¹⁵ В.А. Андрианов, Е.А. Воробьева, А.П. Евсеев, А.Л. Ерзинян, А.А. Буш, П.В. Лямин, П.А. Федин, К.Е. Прянишников, Т.В. Кулевой Радиационные повреждения в окислах железа при имплантации ионов Fe.	174
11 ¹⁵ -11 ³⁰ С.Н. Замодзра Потери энергии нанокластера в твёрдой мишени на стадии обтирки.	175
11 ³⁰ -11 ⁴⁵ Б.Г. Атабаев, И.В. Чурило, Р. Джаббарганов, А.С. Халматов Физическая модель деградации кремниевых солнечных элементов орбитальной станции.	176
11 ⁴⁵ -12 ⁰⁰ Д.В. Кузенко Стабилизация сегнетоэлектрической поляризации ультратонких пленок путем модификации поверхности ионными пучками	177

12⁰⁰-13¹⁵ Заключительная дискуссия**13¹⁵-13³⁰ Объявление победителей конкурса молодых ученых****13³⁰ Заключительное слово**